

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника
в лаборатории наногетероструктурных излучателей и фотоприемников
Вакансия VAC 145814

Тематика исследований

Исследования и разработки технологии пост-ростовой обработки полупроводниковых АЗВ5 гетероструктур фотоэлектрических преобразователей и светоизлучающих диодов.

Трудовая деятельность

- Разработка топологии и конструкции фотоэлектрических преобразователей и светоизлучающих диодов.
- Составление технологического маршрута пост-ростовой обработки АЗВ5 гетероструктур при изготовлении фотоэлектрических преобразователей и светоизлучающих диодов.
- Проведение процессов фотолитографии на полупроводниковых гетероструктурах.
- Исследование материалов и технологии формирования антиотражающих покрытий и металлических контактов фотоэлектрических преобразователей и светоизлучающих диодов.
- Разработка составов и изготовление электролитов для электрохимического осаждения металлических покрытий.
- Разработка технологий жидкостного химического, электрохимического и плазмохимического травления АЗВ5 гетероструктур.
- Разработка и анализ систем комбинированных оптических отражателей.
- Разработка технологии переноса АЗВ5 гетероструктур на подложку-носитель.
- Анализ влияния пост-ростовой обработки на характеристики приборов.
- Участие в подготовке публикаций результатов научно-исследовательских работ в журналах, индексируемых Web of Science и/или Scopus; представление полученных результатов на российских и международных конференциях.
- Участие в работе по регистрации результатов интеллектуальной деятельности.
- Выполнение научных задач и подготовка отчетов по проектам фундаментальных и прикладных исследований в качестве соисполнителя.

Требования к кандидату:

- кандидат физико-математических наук по специальности 1.3.11 «Физика полупроводников».
- Стаж научной работы по специальности не менее 15 лет.
- Число публикаций по теме исследования в рецензируемых журналах не менее 20 по БД Scopus за последние 5 лет.
- Число результатов интеллектуальной деятельности по теме исследования не менее 15.
- Научно-метрические показатели: индексы Хирша не менее 5.
- Участие с докладами в регулярных российских или международных научных конференциях не менее 5 за последние 5 лет.
- Опыт разработки технологических маршрутов пост-ростовой обработки АЗВ5 гетероструктур для изготовления фотоэлектрических преобразователей и светоизлучающих диодов.
- Опыт работы на установках пост-ростовой обработки АЗВ5 гетероструктур, в т.ч. нанесения и экспонирования фоторезистов, электрохимического осаждения металлических покрытий.
- Опыт работы с химическими реактивами, опыт разработки и анализа составов химических травителей и электролитов.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 42600 руб.

СТАВКА: 1.0

Срок трудового договора – до 31.12.2027

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- ☐ копии документов о высшем профессиональном образовании;
- ☐ копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- ☐ сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.